

Qualcomm anuncia el procesador Snapdragon 835 creado a 10 nm



Qualcomm se ha hecho este año con el favor de los fabricantes por el buen trabajo realizado con el Snapdragon 820 y su actualización Snapdragon 821, pero con la vista puesta ya en 2017 la compañía ha anunciado el **Snapdragon 835**. Se trata de un SoC (sistema en chip) cuya principal característica es que está fabricado a 10 nm, con lo que traerá mejoras de rendimiento y consumo con él.

El proceso de fabricación que utilizará es el **10 LPE** (*Low Power Early*, primera generación de 10 nm) de tipo FinFET creado por **Samsung**, y si bien no ha dado más detalles de la arquitectura que incluirá, sobre todo si creará una segunda generación de su núcleo Kryo, el chip estará listo para la primera mitad de 2017, por lo que podría dar más detalles del mismo en el **Mobile World Congress**. En ese momento también es previsible que las grandes compañías renueven sus teléfonos insignia con este procesador.

Qualcomm asegura que el proceso 10 LPE FinFET permitirá un 30 % más de aprovechamiento de la superficie del chip, con un **27 % más de rendimiento** y un **40 % menos de consumo**. Lo que no se está consiguiendo con nuevas tecnologías de baterías, se va a conseguir a base de optimización de los SoC. Qualcomm también ha indicado que ahora mismo hay más de 200 teléfonos en desarrollo que usarán los Snapdragon 820 y 821.

Fuente: geektopia.